



(11) Numéro de publication : **0 561 672 A1**

(12) **DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

(21) Numéro de dépôt : 93400623.0

(51) Int. Cl.⁵ : **H01S 3/06, G02B 6/12,
G02B 6/30**

(22) Date de dépôt : 11.03.93

(30) Priorité : 13.03.92 FR 9203013

(43) Date de publication de la demande :
22.09.93 Bulletin 93/38

(84) Etats contractants désignés :
DE FR GB NL

(71) Demandeur : **COMMISSARIAT A L'ENERGIE
ATOMIQUE**
31-33, rue de la Fédération
F-75015 Paris (FR)

(72) Inventeur : **Valette, Serge**
41 rue des Eaux Claires
F-38100 Grenoble (FR)

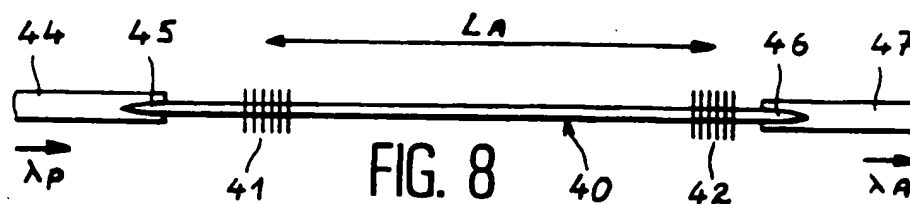
(74) Mandataire : **Mongrédiën, André et al**
c/o BREVATOME 25, rue de Ponthieu
F-75008 Paris (FR)

(54) **Amplificateur optique intégré et laser mettant en oeuvre un tel amplificateur.**

(57) L'invention concerne un amplificateur optique intégré comprenant, sur un substrat en silicium, un guide principal qui reçoit, en une première extrémité, un signal d'entrée et qui délivre, en une seconde extrémité, un signal de sortie, ce guide principal comportant une zone intermédiaire formant un guide d'un premier type comprenant une couche guidante (37) utilisant un matériau à très forte différence d'indice ΔN : $\Delta N \geq 0,3$ par rapport à une couche supérieure (39) et une couche inférieure (36) entre lesquelles la couche guidante est intercalée, ce guide du premier type étant, entouré de deux zones extérieures formant chacune un guide d'un second type permettant de rendre le guide du premier type compatible avec une fibre monomode (13, 14), les transitions entre les deux types de guides étant des transitions adiabatiques. La zone intermédiaire comprend une zone amplificatrice dans laquelle la couche guidante est dopée par implantation ionique d'au moins une terre rare et le guide principal est associé à des moyens d'introduction d'une onde de pompe.

L'invention concerne également un laser mettant en oeuvre un tel amplificateur.

Application notamment aux télécommunications optiques.



EP 0 561 672 A1

Domaine technique

La présente invention concerne un amplificateur optique intégré et un laser mettant en oeuvre un tel amplificateur.

L'invention trouve des applications générales en télécommunications optiques.

Etat de la technique antérieure

Dans le domaine des télécommunications optiques, il est fait usage depuis quelques années d'amplificateurs à fibres optiques, particulièrement avantageux parce qu'ils améliorent considérablement les aspects systèmes.

On peut donc s'attendre dans les années à venir à une influence très forte de ce type de composants combinés entre eux pour former des dispositifs optiques intégrés, à condition bien sûr de savoir les réaliser. Par exemple, l'insertion d'un tel amplificateur dans un diviseur de 1 à N permet d'obtenir N signaux identiques sans perte de puissance entre la voie d'entrée et chacune des voies de sortie prises individuellement.

Dans le domaine des télécommunications optiques des amplificateurs de ce type permettent de transmettre des données optiques sur de grandes distances, avec une atténuation très faible.

De tels amplificateurs sont décrits dans les articles suivants :

- E.K. Mwarania, L. Reekie, J. Wang, J.S. Wilkinson, "Low-threshold monomode ion-exchanged waveguide lasers in neodymium-doped BK-7 glass", Electronics Letters, 2 août 1990, volume 26, N° 16. Cet article décrit des lasers réalisés avec des guides optiques en verre pour lesquels on utilise des verres spéciaux à dopage terre rare, en général erbium. On réalise ces guides en utilisant les méthodes connues d'échange d'ions. Dans de telles méthodes le verre est dopé à la fabrication ; il n'est donc pas possible d'obtenir une plaque ne comprenant que certaines zones limitées qui soient dopées : toute la plaque est obligatoirement dopée ;
- Yoshinori Hibino, Takeshi Kitagawa, Makoto Shimizu, Fumiaki Hanawa et Akio Sugita, "Neodymium-doped silica optical waveguide laser on silicon substrate", IEEE Photonics Technology Letters, volume 1, N° 11, novembre 1989 ;
- K. Kitagawa, K. Hattori, M. Shimizu, Y. Ohmori et M. Kobayashi, "Guided-wave laser based on erbium-doped silica planar lightwave circuit", Electronics Letters, 14 février 1991, volume 27, N° 4. Cet article, ainsi que le précédent, décrit un laser avec des guides optiques en silice dopée obtenue par hydrolyse à la flamme. Le dopant, erbium pour des longueurs d'onde au voisinage de 1,54 μm ou néodyme pour des longueurs d'ondes au voisinage de 1,06 μm , est introduit par trempage dans une solution de type chlorure d'erbium avant l'étape de vitrification. Cette opération est rendue possible du fait de la consistance poreuse de la silice (aspect de suie) avant l'étape de vitrification ;
- A. Polman, A. Lidgard, D.C. Jacobson, P.C. Becker, R.C. Kistler, G.E. Blonder et J.M. Poate, "1.54 μm room-temperature luminescence of MeV erbium-implanted silica glass", Applied Physical Letters 57, 24 décembre 1990. Cet article décrit une méthode d'implantation d'ions erbium sur des guides optiques en silice par la technique CVD ("Chemical Vapor Deposition"). Mais l'utilisation d'une telle méthode est difficilement envisageable pour la réalisation d'amplificateurs intégrés pour les raisons suivantes :
 - 1/ l'implantation d'erbium, ion lourd, à forte profondeur (plusieurs micromètres) nécessite des énergies d'implantation considérables. Par exemple, dans l'article cité précédemment, avec une énergie de 9,5 MeV la profondeur R_p atteinte est de l'ordre de 1,25 μm et les effets de l'implantation ne sont notables qu'au voisinage de cette profondeur R_p , sur une largeur R_p de l'ordre de 0,55 μm ,
 - 2/ les guides en silice dopée pour télécommunications optiques utilisent des variations d'indice "cœur-substrat" faibles (quelque 10^{-3} à 10^{-2}) et l'épaisseur du cœur est grande (4 à 8 μm typiquement) afin de présenter une bonne compatibilité avec les fibres optiques monomodes.

Dans de telles conditions, si l'on veut employer une implantation ionique pour réaliser des amplificateurs optiques par dopage terre rare sur les guides en silice CVD, il faut employer des implantations multiénergies de plusieurs MeV qui nécessitent des équipements très lourds et sont d'un coût prohibitif.

Exposé de l'invention

Pour résoudre ces différents problèmes, l'invention propose de réaliser un amplificateur optique intégré par implantation d'ions terre rare sur un guide d'onde utilisant un matériau à très forte différence d'indice Δn par rapport aux matériaux adjacents.

On rappelle qu'une structure guide d'onde consiste généralement en une couche tampon, une couche guide et une couche supérieure empilées sur un substrat, la couche guide ayant un indice de réfraction réel su-

périeur à celui des couches tampon et supérieure. La couche supérieure peut, dans certains cas, être remplacée par de l'air.

La présente invention a pour objet un amplificateur optique intégré comprenant sur un substrat en silicium un guide principal qui reçoit, en une première extrémité, un signal d'entrée, et qui délivre, en une seconde extrémité, un signal de sortie, caractérisé en ce que ce guide principal comporte une zone intermédiaire formant un guide d'un premier type comprenant une couche guidante utilisant un matériau à très forte différence d'indice $\Delta N: \Delta N \geq 0,3$ par rapport à une couche supérieure et une couche inférieure entre lesquelles la couche guidante est intercalée, ce guide du premier type étant entouré de deux zones extérieures formant chacune un guide d'un second type permettant de rendre le guide du premier type compatible avec une fibre optique monomode standard, les transitions entre les deux types de guides étant des transitions adiabatiques, et en ce que la zone intermédiaire comprend une zone amplificatrice dans laquelle la couche guidante est dopée ou codopée par implantation ionique d'au moins une terre rare et le guide principal est associé à des moyens d'introduction d'une onde de pompe.

Avantageusement le guide du premier type comprend une couche supérieure et une couche inférieure en silice et une couche guidante en nitrure de silicium (Si_3N_4), ou en oxynitrure de silicium (SiO_xN_y). Chaque guide du second type comprend une couche guidante en silice intercalée entre une couche supérieure et une couche inférieure en silice (SiO_2), cette couche guidante du guide du second type ayant un indice supérieur à celui des couches inférieure et supérieure, cette condition étant réalisée en dopant convenablement lesdites couches.

Avantageusement si l'on veut émettre ou amplifier la lumière au voisinage de $1,55 \mu\text{m}$ de longueur d'onde, le dopage terre rare est un dopage à l'erbium. Le dopage terre rare peut être également un codopage choisi parmi les possibilités suivantes : erbium-ytterbium, ou erbium-aluminium, ou erbium-ytterbium-aluminium.

La zone amplificatrice subit, avantageusement, un recuit dans une gamme de températures T telle que : $700^\circ\text{C} < T < 1200^\circ\text{C}$. Avantageusement la couche guidante dans la zone intermédiaire est en nitrure de silicium d'épaisseur comprise entre $0,04$ et $0,3 \mu\text{m}$ typiquement pour les longueurs d'onde qui intéressent les télécommunications optiques. Une implantation de quelques centaines de KeV d'ions terre rare suffit alors à faire pénétrer l'ion en question sur une profondeur très voisine des dimensions du guide. La couche guidante dans chaque zone extérieure peut être réalisée en silice dopée par dopage d'au moins l'un des composants suivants : phosphore, bore, azote, germanium ou titane ; ou en silice non dopée ou dopée au fluor, les couches inférieure et supérieure associées étant alors dopées au fluor avec des concentrations moins fortes que celles utilisées dans la couche guidante.

Dans une première configuration, les moyens d'introduction de l'onde de pompe comprennent au moins un guide secondaire réalisé sur le substrat, couplé au guide principal dans tout ou partie de sa zone intermédiaire, ce guide secondaire véhiculant au moins une onde de pompe. Chaque guide secondaire comprend une première partie, couplée à la zone intermédiaire, formée d'un guide du premier type, et au moins une seconde partie formée d'un guide du second type, reliée à la première partie par une transition adiabatique. Dans une telle configuration, la zone amplificatrice est réalisée par implantation dans les guides principal et secondaire au niveau de leur partie couplée.

Dans une seconde configuration, l'amplificateur comprend deux guides secondaires, la zone amplificatrice du guide principal étant disposée dans la zone intermédiaire au moins dans la partie non couplée des guides principal et secondaires et entre les guides secondaires. La zone amplificatrice est implantée uniquement dans le guide principal au niveau de cette zone intermédiaire. Avantageusement, dans la zone amplificatrice le guide principal est réalisé dans un guide ayant la forme d'une spirale, afin d'augmenter la longueur d'amplification sans augmenter notablement le volume du composant.

Dans une autre configuration avantageuse, on réalise un laser mettant en oeuvre un amplificateur selon l'invention, une zone amplificatrice étant située entre deux réseaux optiques qui permettent un retour sur elle-même de la longueur d'onde amplifiée.

Brève description des dessins

- La figure 1 illustre une première configuration d'un amplificateur optique intégré conforme à l'invention ;
- la figure 2 illustre une seconde configuration d'un amplificateur optique intégré conforme à l'invention ;
- la figure 3 illustre une variante de la seconde configuration représentée à la figure 2 ;
- la figure 4 illustre une vue en coupe transversale de la première configuration selon un plan IV-IV représenté à la figure 1 ;
- les figures 5 à 7 illustrent plusieurs caractéristiques de l'amplificateur selon l'invention ;
- la figure 8 illustre un laser mettant en oeuvre un amplificateur selon l'invention ;
- la figure 9 représente des courbes explicatives du fonctionnement de l'amplificateur optique de l'invention.

- tion ;
- la figure 10 illustre une réalisation avantageuse.

Exposé détaillé des modes de réalisation

Dans la suite de la description, la structure guide $\text{Si}/\text{SiO}_2/\text{Si}_3\text{N}_4/\text{SiO}_2$ comprenant une couche supérieure et une couche inférieure en silice et une couche guidante en nitrure de silicium sera appelée structure OIS1, la structure guide $\text{Si}/\text{SiO}_2/\text{SiO}_2$ haut indice/ SiO_2 comprenant une couche supérieure et une couche inférieure en silice et une couche guidante en silice dopée avec des dopants augmentant son indice de réfraction sera appelée structure OIS2.

L'amplificateur optique intégré de l'invention est réalisé par implantation ionique de terre rare, par exemple erbium, sur un guide de type OIS1 qui utilise un matériau à très forte différence d'indice ΔN par rapport aux matériaux adjacents. En effet, on a :

$$n_{\text{SiO}_2} \approx 1,45$$

$$n_{\text{Si}_3\text{N}_4} \approx 2$$

Avantageusement $\Delta N \geq 0,3$ avec une épaisseur de coeur de guide W telle que : $W_{\min} \leq W \leq 0,4 \mu\text{m}$. Sur la figure 9, est représentée l'évolution de l'épaisseur effective W_e du mode guidé (W_e correspond à la largeur de ce mode pour une amplitude mesurée à $1/e$ par rapport à l'amplitude maximum) en fonction de l'épaisseur du coeur W pour un écart d'indice ΔN donné.

Sur cette figure on voit que, pour avoir une largeur du mode W_e inférieure à une valeur donnée, il faut choisir W_e valeur minimale de ΔN (par exemple sur la figure 9, $W_e \leq 1 \mu\text{m}$ entraîne $\Delta N \geq 0,3$). Dans ces conditions on voit également que W est compris entre une valeur maximum W_{\max} et une valeur minimum W_{\min} . Par ailleurs W_{\max} sera aussi limitée par la profondeur d'implantation accessible avec les énergies d'implantation maximum dont nous disposons. Le choix d'une valeur limite pour W_e (par exemple $1 \mu\text{m}$ dans notre cas) est dicté par le souci d'obtenir un taux d'amplification suffisant (et donc une largeur d'amplification pas trop grande) compte tenu des concentrations d'ions implantés accessibles en pratique.

Il faut alors recuire la zone implantée pour guérir les défauts dus au bombardement et avoir de l'erbium dans une matrice cristalline (Si_3N_4 ou SiOxNy ...) pas trop perturbée. La température optimum dépend de la nature du matériau constituant la matrice. On peut définir une gamme générale de températures T telle que : $700^\circ\text{C} < T < 1200^\circ\text{C}$; avantageusement avec du nitrure de silicium : $1000^\circ\text{C} < T < 1200^\circ\text{C}$.

L'erbium est utilisé car il permet une amplification aux longueurs d'ondes utilisées en télécommunication optique : $\lambda \approx 1,54 \mu\text{m}$. Mais il est possible d'utiliser d'autres terres rares, ou d'utiliser des codopages tels que erbium-ytterbium, ou erbium-aluminium, ou erbium-ytterbium-aluminium ; l'ytterbium permettant d'améliorer l'absorption du faisceau de pompe et l'aluminium permettant d'homogénéiser la réponse spectrale en amplification.

L'amplificateur représenté sur la figure 1 est réalisé sur un substrat 10. Il comprend un guide principal 11 véhiculant le signal à amplifier (longueur d'onde λ_s) auquel est couplé un guide secondaire 12 véhiculant une onde de pompe (longueur d'onde λ_p) dans chaque sens.

Le guide principal, disposé ici entre une fibre optique monomode d'entrée 13 et une fibre optique monomode de sortie 14, comprend une zone intermédiaire 15 ayant une structure de type OIS1 située entre deux zones 16 et 17 ayant une structure de type OIS2. Les deux transitions 18 et 19 entre ces deux types de zones sont des transitions adiabatiques.

Le guide secondaire, disposé ici entre deux diodes laser 20 et 21 comprend, lui aussi, une zone intermédiaire 22 ayant une structure de type OIS1 située entre deux zones 23 et 24 ayant une structure de type OIS2. Les deux transitions 25 et 26 entre ces deux types de zones sont des transitions adiabatiques.

Dans cette première configuration l'utilisation d'un coupleur bidirectionnel n'est pas obligatoire : elle permet seulement d'augmenter l'énergie de pompe et donc d'obtenir une amplification plus forte sur des distances d'interaction plus courtes.

Dans la seconde configuration représentée à la figure 2, le coupleur bidirectionnel 11-12 de la figure 1 est remplacé par deux coupleurs séparés 11-31, 15-32.

Le choix de l'une ou l'autre de ces deux configurations dépend des coefficients d'amplification g_s (pour la longueur d'onde du signal à amplifier) et d'absorption α_p (pour la longueur d'onde de pompe λ_p) et des caractéristiques des coupleurs désirés.

Si les coefficients d'amplification et d'absorption g_s et α_p sont grands et donc si la longueur d'absorption LA du faisceau pompe ($LA \approx 1/\alpha_p$) est faible (quelques millimètres au moins), la première configuration, représentée à la figure 1, est plus avantageuse.

Si au contraire la longueur d'absorption LA est grande (plusieurs centimètres ou plus), la seconde confi-

guration, représentée à la figure 2, avec deux coupleurs indépendants est plus favorable.

Dans la seconde configuration la zone intermédiaire 33 peut favorablement être choisie pour optimiser l'amplification. Si l'amplification est faible cette zone 33 aura intérêt à être la plus grande possible. Elle pourra par exemple prendre la forme d'un guide "spirale" tel que représenté sur la figure 3, qui permet d'obtenir de grandes longueurs de guidage, par exemple de l'ordre du mètre, sans augmentation notable de la taille du dispositif.

La structure représentée à la figure 4 est une vue en coupe du coupleur utilisé dans les deux configurations, par exemple selon le plan de coupe IV-IV de la figure 1. Le substrat 35 est en silicium monocristallin. La couche tampon 36 est en oxyde de silicium d'indice n_2 de 2 à 15 μm d'épaisseur, obtenue par oxydation thermique haute pression du substrat ou par dépôt chimique en phase vapeur assisté par un plasma (PECVD). La couche guide 37 est une couche de nitrure de silicium de 50 à 500 nm d'épaisseur, obtenue par dépôt chimique en phase vapeur basse pression (LPCVD) ou assisté par un plasma (PECVD). Les deux surplots 38 de confinement latéral de la lumière sont des couches d'oxyde de silicium d'indice n_1 voisin ou égal à n_2 , de 0,5 à 5 μm déposées par PECVD ou LPCVD. La couche de diélectrique 39 est une couche diélectrique d'indice $n_D < n_1$. La silice a un premier indice réel n_1 de 1,45 environ, le diélectrique un indice réel n_D de 1,40 environ, et le nitrure de silicium un indice voisin de 2.

Le fait d'associer un guide de type OIS1 à un guide de type OIS2, via une transition adiabatique, permet de rendre un guide de type OIS1 compatible avec une fibre optique monomode standard. Dans un guide de type OIS2, c'est-à-dire de structure $\text{Si}/\text{SiO}_2/\text{SiO}_2$ haut indice/ SiO_2 , l'oxyde de silicium ou silice (SiO_2) haut indice peut être obtenu par dopage de bore, d'azote, de phosphore, germanium ou titane... ou par absence de dopage si la silice environnante est dopée par un dopant qui diminue l'indice de réfraction (fluor...).

Les zones de transition adiabatiques, qui peuvent être réalisées comme décrit dans le document "Applied Physical Letters" 55 (23) du 4 décembre 1989, pages 2389-2391, de Y. Shani et al. "Efficient coupling of a semiconductor laser to an optical fiber by means of a tapered waveguide on silicon", permettent de coupler efficacement (90 % ou plus) de la lumière d'un guide du type OIS1 vers un guide de type OIS2 correspondant et inversement.

Une transition de ce type est représentée sur les figures 5a et 5b, respectivement en représentation schématique et en coupe longitudinale.

La transition représentée permet donc par exemple de passer d'un guide 11 de type OIS1 à un guide 16 de type OIS2. On retrouve sur ces figures 5a et 5b les couches déjà représentées en figure 4.

Le guide 11 comporte un substrat 35 en silicium monocristallin recouvert d'une couche de confinement inférieure 36 en oxyde de silicium (SiO_2). Sur cette couche on trouve une couche guidante 37 en nitrure de silicium définissant le guide 11, et deux couches successives de confinement, la première 38 ayant un dopage tel que l'indice soit supérieur à celui de la couche 36 et celui de la couche 39. Dans chaque guide 11 (16), et également dans la zone de transition 18, la couche de guidage présente un indice de réfraction supérieur à celui des couches qui l'entourent.

Dans la zone adiabatique la couche guidante 37 en nitrure de silicium a une largeur qui diminue progressivement vers zéro.

Le guide OIS2 peut être gravé ou non suivant le pointillé à la fin de la zone de transition.

Dans les deux configurations représentées aux figures 1 et 2 les transitions adiabatiques 18 et 19 sont indispensables car on doit recoupler la lumière sur des fibres optiques monomodes, par exemple des fibres optiques 13 et 14. Pour réaliser ces connexions fibres optiques-guides optiques, on peut avantageusement utiliser le procédé décrit dans la demande de brevet français N° 90 02575 du 1er mars 1990.

Par contre les transitions adiabatiques 25 et 26 ne sont pas indispensables. Mais elles permettent de coupler les diodes laser de pompe 20 et 21 dans les guides 23 et 24 de type OIS2, ce qui a pour effet de faciliter le couplage du point de vue sensibilité de positionnement. Il est cependant tout à fait envisageable de supprimer ces deux transitions 25 et 26 et d'utiliser un couplage direct entre les diodes de pompe 20 et 21 et le guide 22 (ou l'un des guides 31 et 32) de type OIS1.

Dans un exemple de réalisation de l'amplificateur optique intégré selon l'invention, la zone intermédiaire 15 a les caractéristiques suivantes :

- coeur en nitrure de silicium d'épaisseur 0,16 μm ,
- implantation erbium.

On peut utiliser une énergie 300 KeV, dose $\approx 10^{14} \text{ cm}^{-2}$ à 10^{15} cm^{-2}

$$R_p \approx 0,11 \mu\text{m}$$

$$\Delta R_p \approx 0,005 \mu\text{m}$$

On peut également réaliser une implantation multiénergie telle que :

$$E_1 \approx 50 \text{ KeV}$$

$$E_2 \approx 120 \text{ KeV}$$

$$E_3 = 300 \text{ KeV}$$

Une telle implantation couvre à peu près toute l'épaisseur du guide et assure donc une concentration homogène et forte d'erbium dans tout le coeur et une amplification efficace de la lumière dans la bande spectrale correspondante.

Un recuit reste cependant nécessaire pour éliminer les défauts dus au bombardement ionique et rendre les ions terre rare actifs.

Les paramètres de tels recuits sont connus et se situent à des températures de l'ordre de 600 à 1000°C pendant des durées de 30' à 3 heures suivant le degré d'amélioration souhaité et de la dose d'implantation choisie.

Pour simplifier l'explication qui va suivre, seule la première configuration sera prise en compte, le coupleur considéré étant alors unidirectionnel. Une explication analogue pourrait être tout aussi bien développée pour la première configuration avec un coupleur bidirectionnel, ou pour la seconde configuration.

la longueur d'onde du signal optique à amplifier λ_s est ici égale ou voisine de 1,54 μm .

La longueur d'onde de pompe p peut être choisie assez librement dans le spectre d'absorption du nitrure de silicium Si_3N_4 dopé à l'erbium.

Il n'est bien sûr pas possible que les coupleurs puissent, par exemple, garder en permanence toute l'énergie du signal à la longueur d'onde signal λ_s dans le guide principal 11 et d'amener toute l'énergie de pompe à la longueur d'onde de pompe p du guide secondaire 12 au guide principal 11. En pratique, le coupleur réalise un échange à la fois pour les longueurs d'onde λ_s et λ_p .

Si on néglige les coefficients de perte α_p et d'amplification g_s , la réponse d'un coupleur est de la forme suivante bien connue :

1/ pour la longueur d'onde de signal λ_s :

$$\text{- dans le guide principal : } I_s^1 = I_{s0} \cos^2 K_{sz}$$

$$\text{- dans le guide secondaire : } I_s^2 = I_{s0} \sin^2 K_{sz}$$

2/ pour la longueur d'onde de pompe λ_p :

$$\text{- dans le guide principal : } I_p^1 = I_{p0} \sin^2 K_{pz}$$

$$\text{- dans le guide secondaire : } I_p^2 = I_{p0} \cos^2 K_{pz}$$

K_s et K_p sont les coefficients de couplage aux longueurs d'ondes λ_s et λ_p .

Les longueurs de couplage correspondantes, c'est-à-dire les longueurs pour lesquelles il y a échange complet d'énergie entre les guides principal et secondaire, sont

$$L_p = \pi/2K_p \quad L_s = \pi/2K_s$$

Etant donné que la longueur d'onde de pompe λ_p est plus faible que la longueur d'onde de signal λ_s , la longueur de couplage L_p sera généralement plus grande que la longueur de couplage L_s pour une configuration de coupleur donnée. On choisit avantageusement la longueur d'interaction du coupleur L_i (distance pour lequel il y échange d'énergie lumineuse entre les deux guides) telle que :

$$L_i \approx L_p = 2L_s$$

Les échanges d'énergie entre les guides principal et secondaire sont donc alors schématisés par le diagramme de la figure 6.

Sur la longueur L_i , l'énergie de signal (λ_s) passe du guide principal 11 au guide secondaire 12, puis revient dans le guide principal 11.

Sur la même longueur L_i l'énergie de pompe (λ_p) passe du guide secondaire 12 au guide principal 11 suivant les formules données plus haut (si α_p et g_s sont faibles, ce qui sera en général le cas).

On peut considérer l'exemple chiffré suivant (en faisant référence à la figure 4) :

avec

$$\lambda_s = 1,55 \mu\text{m}$$

$$\lambda_p = 0,98 \mu\text{m}$$

on obtient

$$n_{\text{SiO}_2} = 1,45 \text{ à } 0,98 \mu\text{m} ; \text{ et}$$

$$n_{\text{SiO}_2} = 1,44 \text{ à } 1,55 \mu\text{m}$$

$$n_{\text{Si}_3\text{N}_4} = 1,98 \quad \begin{cases} 1,986 \text{ à } 0,98 \mu\text{m} \\ 1,976 \text{ à } 1,55 \mu\text{m} \end{cases}$$

$$n_D = 1 \text{ (air)}$$

$W=1 \mu\text{m}$
 $S=0,8 \mu\text{m}$
 $L_p=L_s=88,8 \mu\text{m} \Rightarrow L_s$ sera plus important
 avec $nD=1,40$, S de l'ordre de 1 à $8 \mu\text{m}$
 et W de 1 à $8 \mu\text{m}$.

Ceci n'est qu'un exemple, il existe une infinité de solutions.

Il est clair que les zones d'implantation utiles seront toujours celles où il y a à la fois le faisceau de signal et le faisceau de pompe.

Dans la première configuration de la figure 1, l'implantation a lieu au niveau du coupleur et affecte à la fois les guides principal 11 et secondaire 12.

Dans la deuxième configuration de la figure 2, la zone implantée sera favorablement la zone intermédiaire 33 et n'affecte que le guide principal 11.

Bien entendu des configurations intermédiaires peuvent être utilisées pour tenir compte de cas pratiques qui se situent entre les configurations des figures 1 et 2 avec des zones intercoupleur de longueur L_{ZC} pas très différentes des longueurs d'interaction des coupleurs L_s .

Des implantations localisées convenablement entre les guides 1 et 2 peuvent alors être favorables.

Si $L_{ZC} \approx L_s$ on peut avoir la configuration représentée à la figure 7. Sur cette figure les zones implantées peuvent avoir l'emplacement des zones hachurées.

Dans toutes les configurations selon l'invention, la zone amplificatrice est avantageusement implantée sur les portions de guide où les ondes de signal et de pompe sont présentes de manière notable. Si l'une ou l'autre de ces ondes est absente ou simplement faible dans la portion considérée, l'implantation ionique ne fera qu'augmenter l'absorption d'une ou de ces deux ondes, ce qui est préjudiciable au rendement global de l'amplificateur.

Pour réaliser la zone intermédiaire 15 du guide principal 11, le guide le plus favorable est de type OIS1 avec un coeur en nitrure de silicium. Toutefois, on peut envisager un procédé analogue avec des guides de coeur SiOxNy dont l'indice serait suffisamment élevé ($n\text{SiOxNy} > 1,75$).

Une structure OIS1 de type avantageux est représentée sur la figure 10, avec une zone amplificatrice 50. Elle permet, en effet, d'obtenir une amplification insensible à la polarisation : c'est-à-dire obtenir une amplification voisine dans les deux polarisations TE et TM à condition que $N \leq 5 \times 10^{-2}$.

L'épaisseur des couches adjacentes au coeur est considérée comme infinie, c'est-à-dire supérieure à la pénétration de l'onde évanescente dans ces couches ; en pratique cette épaisseur est de l'ordre de un à quelques microns. Cette structure de microguide peut être limitée, comme représenté sur la figure 10, avec les valeurs numériques suivantes :

$$N \sim 1,45$$

$$\Delta N \sim 0,55$$

$$\delta N \sim 2 \cdot 10^{-2}$$

$$L \sim 4 \mu\text{m}$$

$$W \sim 0,3 - 0,4 \mu\text{m}.$$

La couche supérieure est composée d'une couche centrale d'indice N gravée de façon à définir la largeur L du coeur en Si_3N_4 et d'une couche d'indice $N-\delta N$ disposée soit de part et d'autre de la couche centrale, soit recouvrant celle-ci.

L'amplificateur de l'invention décrit précédemment peut être utilisé pour réaliser un laser, tel que représenté sur la figure 8. On introduit alors un élément optique capable de jouer le rôle de résonateur et l'on supprime le signal de longueur d'onde λ_s . Avantageusement les éléments résonateurs peuvent être réalisés par des réseaux 41 et 42 dont le pas p est calculé pour assurer un retour de la lumière amplifiée dans le milieu amplificateur 40. Le signal optique en entrée est véhiculé par un guide 44 de type OIS2 et transite par une transition adiabatique 45 avant d'atteindre le réseau 41. Le signal optique en sortie du second réseau 42 est véhiculé par un guide 46 de type OIS2 après passage dans une transition adiabatique 47. En pratique, il est bien connu que le pas p est égal à :

$$p = \lambda A / 2nA$$

λA étant ici la longueur d'onde de lumière émise dans la partie amplificatrice 40 (qui aura donc le même rôle que λ_s dans le cas précédent) et nA l'indice effectif du mode guide dans le guide de lumière.

Bien entendu dans cette configuration les coupleurs ne sont plus nécessaires car il n'y a plus de signal de longueur d'onde λ_s mais seulement un signal de sortie à la longueur d'onde λA fourni par la partie amplificatrice de longueur LA .

La longueur d'onde de pompe λ_p peut donc être directement injectée dans le guide principal suivant les moyens décrits précédemment.

les réseaux 41 et 42 permettent un retour sur elle-même de la longueur d'onde amplifiée nA mais trans-

mettent intégralement le signal de pompe λ_p .

La zone implantée amplificatrice 40 est comprise entre ces réseaux 41 et 42 et sa longueur LA est optimisée en fonction du coefficient d'amplification g désiré. En pratique, on s'arrange pour que cette longueur LA corresponde à peu près à la longueur sur laquelle le coefficient g reste positif, c'est-à-dire la longueur pour laquelle le faisceau de pompe produit une inversion de population suffisante pour assurer un gain d'amplification supérieur aux pertes de propagation du faisceau à amplifier.

Dans le cas de l'amplificateur de l'invention, l'implantation d'erbium est favorable car elle conduit à une amplification de lumière autour de la longueur d'onde 1,54 μm qui est celle choisie pour les communications optiques. Dans le cas des lasers d'autres longueurs d'ondes d'émission peuvent être intéressantes : l'implantation d'erbium peut donc être remplacée par une implantation d'un autre élément dans la mesure où la lumière émise en excitant les transitions radiatives par la lumière de pompe se situe dans une zone de transparence des guides considérés non implantés.

Il est bien entendu que la présente invention n'a été décrite et représentée qu'à titre d'exemple préférentiel et que l'on pourra remplacer ses éléments constitutifs par des éléments équivalents sans, pour autant, sortir du cadre de l'invention.

Revendications

1. Amplificateur optique intégré comprenant sur un substrat (10) en silicium, un guide principal (11) qui reçoit, en une première extrémité, un signal d'entrée et qui délivre, en une seconde extrémité, un signal de sortie, caractérisé en ce que ce guide principal (11) comporte une zone intermédiaire (15) formant un guide d'un premier type comprenant une couche guidante (37) utilisant un matériau à très forte différence d'indice $\Delta N : \Delta N \geq 0,3$ par rapport à une couche supérieure (39) et une couche inférieure (36) entre lesquelles la couche guidante est intercalée, ce guide du premier type étant entouré de deux zones extérieures (16, 17) formant chacune un guide d'un second type permettant de rendre le guide du premier type compatible avec une fibre monomode (13, 14), les transitions (18, 19) entre les deux types de guides étant des transitions adiabatiques, et en ce que la zone intermédiaire (15) comprend une zone amplificatrice dans laquelle la couche guidante est dopée ou codopée par implantation ionique d'au moins une terre rare et le guide principal est associé à des moyens d'introduction d'une onde de pompe.
2. Amplificateur selon la revendication 1, caractérisé en ce que le guide du premier type comprend une couche supérieure (39) et une couche inférieure (36) en silice et une couche guidante (37) en nitrure de silicium ou en oxy-nitrure de silicium SiO_xN_y , et en ce que chaque guide du second type comprend une couche guidante en silice intercalée entre une couche supérieure (39) et une couche inférieure (36) en silice, cette couche guidante du guide du second type ayant un indice supérieur à celui des couches inférieure et supérieure, cette condition étant réalisée en dopant convenablement lesdites couches.
3. Amplificateur selon la revendication 1, caractérisé en ce que le dopage terre rare est un dopage à l'erbium.
4. Amplificateur selon la revendication 1, caractérisé en ce que le dopage terre rare est un codopage choisi parmi les possibilités suivantes : erbium-ytterbium, ou erbium-aluminium, ou erbium-ytterbium-aluminium.
5. Amplificateur selon la revendication 1, caractérisé en ce que la zone amplificatrice subit un recuit dans une gamme de températures T telle que : $700^\circ\text{C} < T < 1200^\circ\text{C}$.
6. Amplificateur selon la revendication 2, caractérisé en ce que la couche guidante (37) dans la zone intermédiaire (15) est en nitrure de silicium d'épaisseur comprise entre 0,04 et 0,3 micromètres.
7. Amplificateur selon la revendication 2, caractérisé en ce que la couche guidante (38) dans chaque zone extérieure (16, 17) est réalisée en silice dopée par dopage d'un au moins des composants suivants : phosphore, germanium, titane, bore et azote.
8. Amplificateur selon la revendication 2, caractérisé en ce que la couche guidante (38) dans chaque zone extérieure (16, 17) est réalisée en silice non dopée ou dopée au fluor, les couches inférieure et supérieure associées étant dopées au fluor avec des concentrations moins fortes que celles utilisées dans la couche guidante.

9. Amplificateur selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens d'introduction de l'onde de pompe comprennent au moins un guide secondaire (12) réalisé sur le substrat et couplé au guide principal (11) dans tout ou partie de sa zone intermédiaire, ce guide secondaire véhiculant au moins une onde de pompe.
- 5 10. Amplificateur selon la revendication 9, caractérisé en ce que chaque guide secondaire (12 ; 31, 32) comprend une première partie couplée à la zone intermédiaire, formée d'un guide du premier type.
11. Amplificateur selon la revendication 10, caractérisé en ce que chaque guide secondaire (12 ; 31, 32) comporte au moins une seconde partie formée d'un guide du second type reliée (23, 24 ; 31, 32) à la première partie par une transition adiabatique (25, 26).
- 10 12. Amplificateur selon l'une quelconque des revendications 9 à 11, caractérisé en ce qu'il comprend un seul guide secondaire (12), la zone amplificatrice étant réalisée par implantation dans les guides principal (11) et secondaire (12) au niveau de leurs parties couplées.
- 15 13. Amplificateur selon l'une quelconque des revendications 9 à 11, caractérisé en ce que la zone amplificatrice est implantée uniquement dans le guide principal (11) au niveau de cette zone intermédiaire (33).
- 20 14. Amplificateur selon l'une quelconque des revendications 7 à 9, caractérisé en ce qu'il comprend deux guides secondaires (31, 32), la zone amplificatrice du guide principal étant disposée dans la zone intermédiaire au moins dans la partie non couplée des guides principal et secondaires et entre les deux guides secondaires.
- 25 15. Amplificateur selon l'une quelconque des revendications 13 ou 14, caractérisé en ce que le guide principal (11) dans la zone amplificatrice est réalisé dans un guide (33) ayant la forme d'une spirale.
- 30 16. Amplificateur selon la revendication 2, caractérisé en ce que le guide du premier type a une couche supérieure comprenant une couche centrale d'indice N entourée de deux couches d'indice N- δN assurant le confinement latéral, telles que $\delta N \leq 5 \cdot 10^{-2}$.
- 35 17. Laser mettant en oeuvre un amplificateur selon l'une quelconque des revendications 1 à 16, caractérisé en ce que la zone amplificatrice (40) est située entre deux réseaux optiques (41, 42) qui permettent un retour sur elle-même de la longueur d'onde amplifiée.
- 40
- 45
- 50
- 55

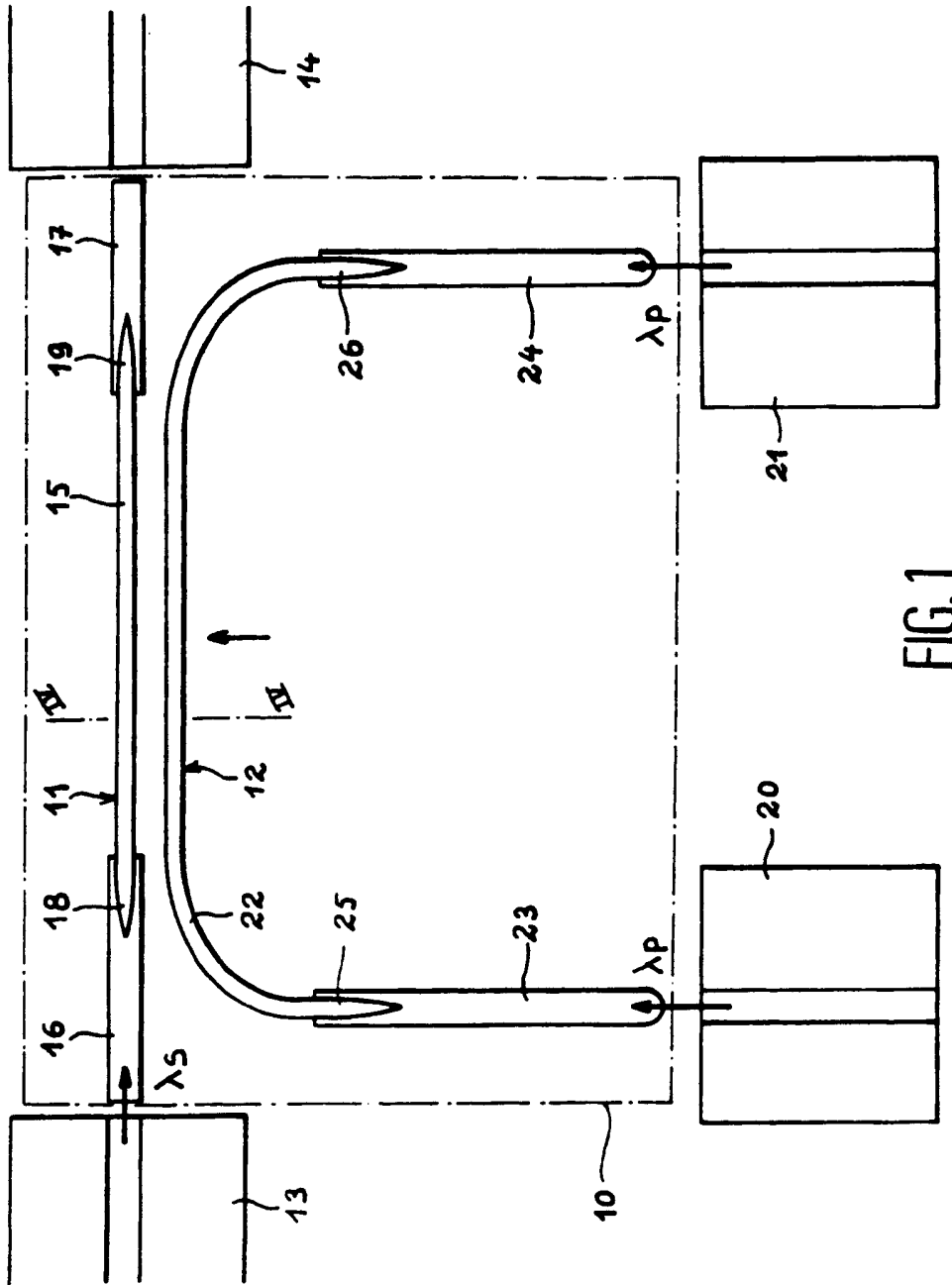
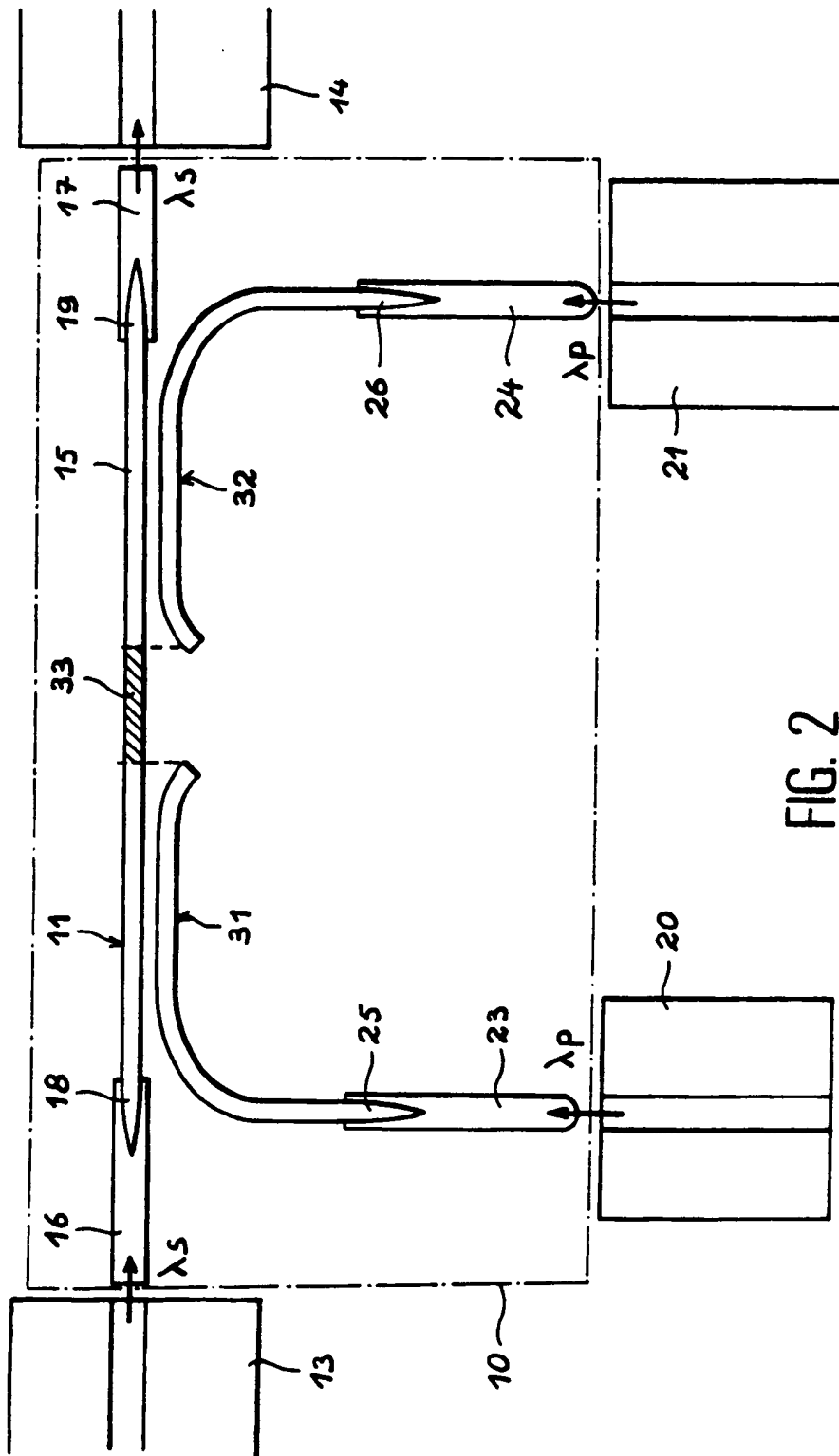


FIG. 1



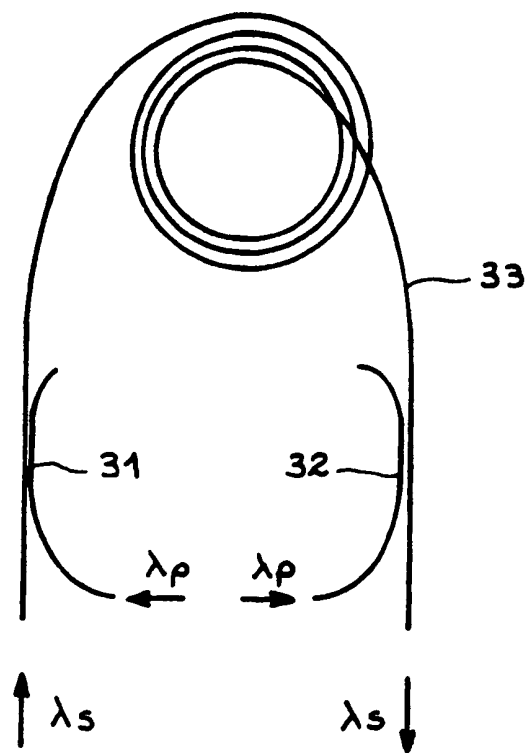


FIG. 3

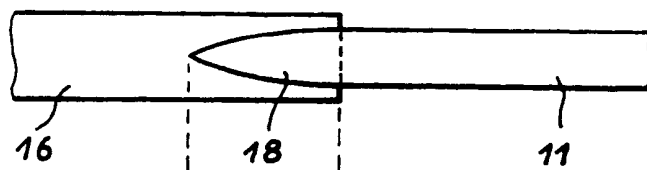


FIG. 5 a

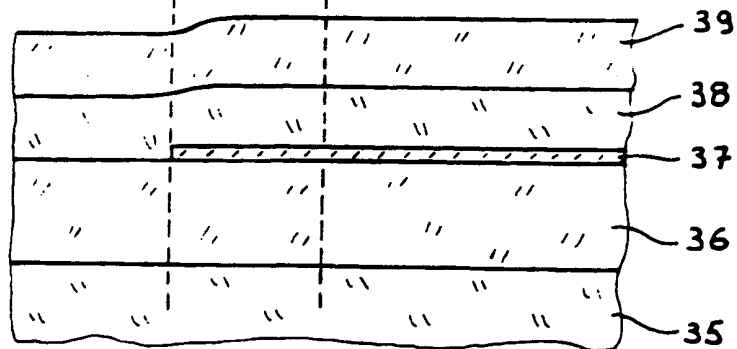


FIG. 5 b

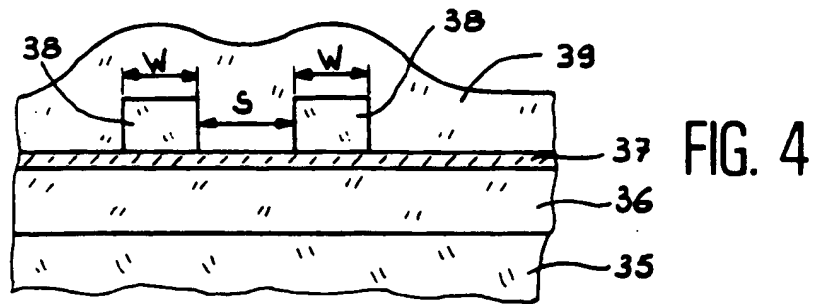


FIG. 4

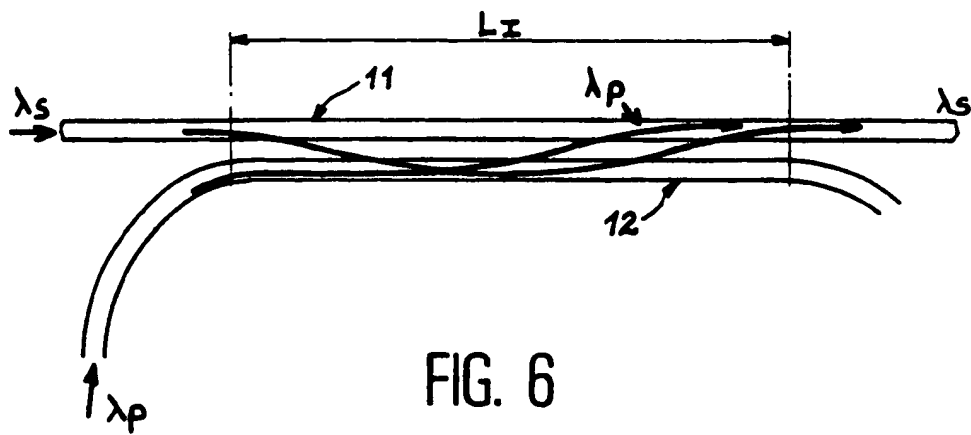


FIG. 6

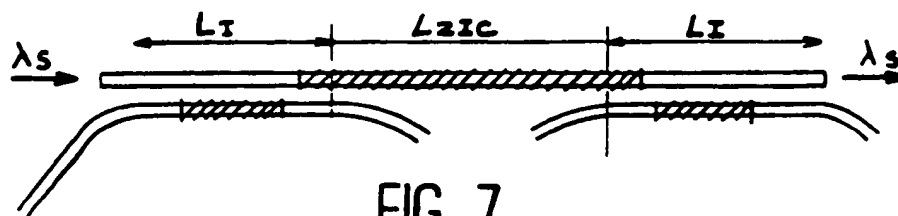


FIG. 7

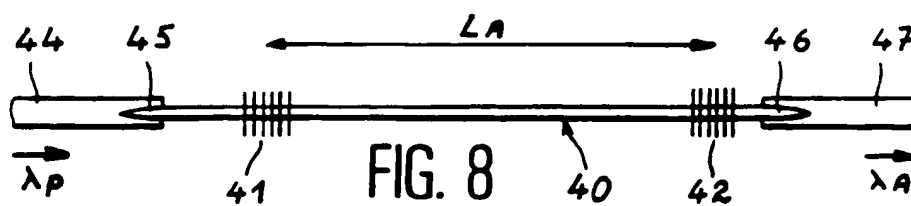


FIG. 8

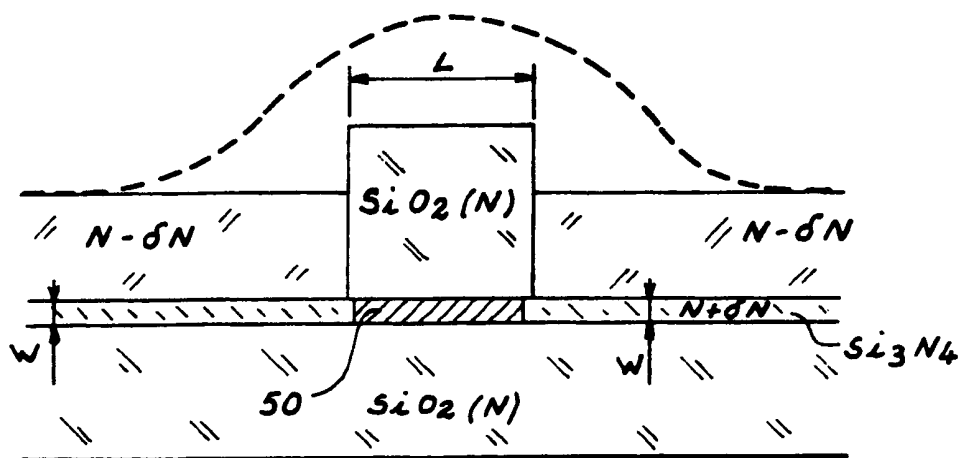
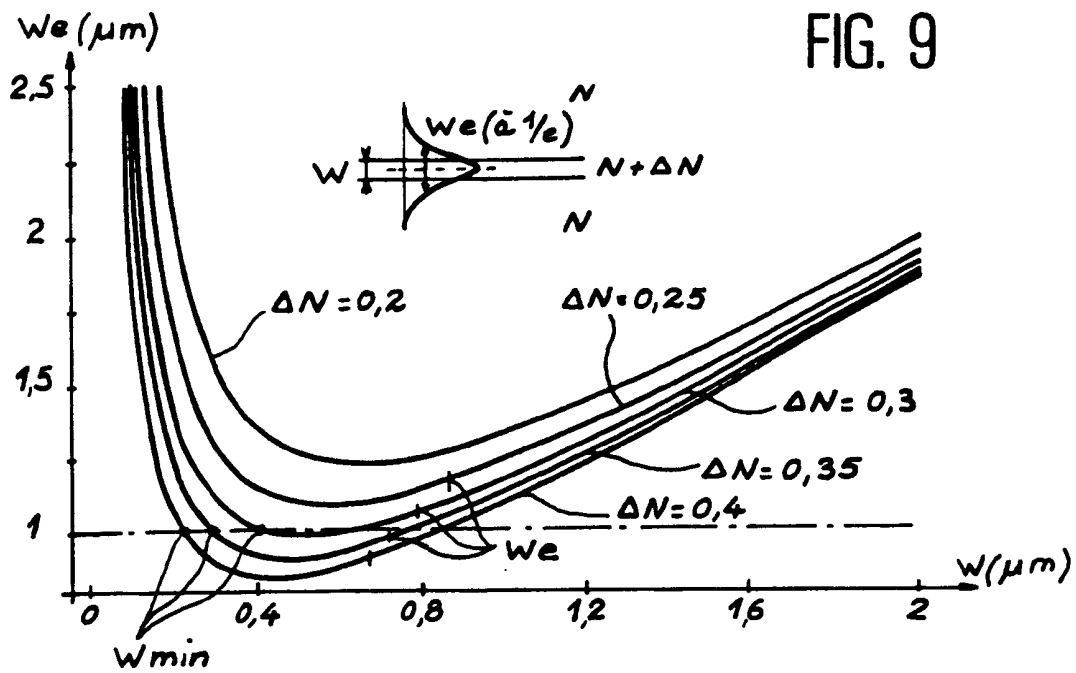


FIG. 10



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande

EP 93 40 0623

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl.5)
D,A	APPLIED PHYSICS LETTERS. vol. 57, no. 26, 24 Décembre 1990, NEW YORK US pages 2859 - 2861 A.POLMAN ET AL. '1.54 um room-temperature luminescence of MeV erbium-implanted silica glass' * abrégé *	1	H01S3/06 G02B6/12 G02B6/30
D,A	ELECTRONICS LETTERS. vol. 27, no. 14, 14 Février 1991, ENAGE GB pages 334 - 335 T.KITAGAWA ET AL. 'Guided-wave laser based on erbium-doped silica planar lightwave circuit' * abrégé *	1	
A	EP-A-0 440 049 (CORNING INC.) * abrégé *	1	
A	DE-A-4 120 054 (HITACHI CABLE,LTD) * abrégé *	1	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5)
A	EP-A-0 474 447 (AT&T CO) * abrégé *	1	H01S
D,A	APPLIED PHYSICS LETTERS. vol. 55, no. 23, 4 Décembre 1989, NEW YORK US pages 2389 - 2391 Y.SHANI ET AL. 'Efficient coupling of a semiconductor laser to an optical fiber by means of a tapered waveguide on silicon' -----		
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 02 JUILLET 1993	Examinateur GALANTI M.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES		<p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons</p> <p>Δ : membre de la même famille, document correspondant</p>	
<p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p>			

EPO FORM 1503 (01.92) (P0602)

THIS PAGE BLANK (USPTO)